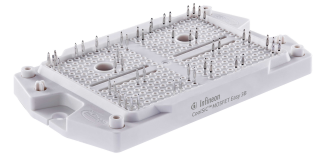


EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{DS} = 1200\text{ V}$
 - $I_{DN} = 400\text{ A} / I_{DRM} = 800\text{ A}$
 - Niedrige Schaltverluste
 - Hohe Stromdichte
 - Niederinduktives Design
- Mechanische Eigenschaften
 - PressFIT Verbindungstechnik
 - Integrierter NTC Temperatur Sensor
 - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern



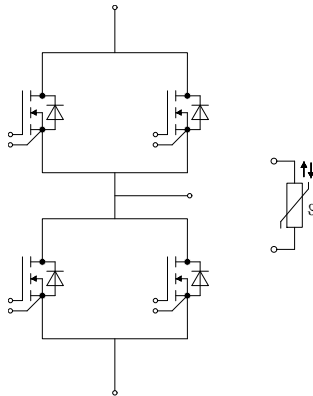
Potenzielle Anwendungen

- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- Solar Anwendungen
- USV-Systeme
- DC/DC Wandler
- Servoumrichter

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	MOSFET	3
3	Body diode	5
4	NTC-Widerstand	6
5	Kennlinien	7
6	Schaltplan	12
7	Gehäuseabmessungen	13
8	Modul-Label-Code	14
	Änderungshistorie	15
	Disclaimer	16

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.0	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	9.6	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	11.3	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	9.2	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	10.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 400	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			5		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{\text{CC}'+\text{EE}'}$	$T_{\text{H}}=25^\circ\text{C}$, pro Schalter		0.235		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	1.3		1.5	Nm
Gewicht	G			78		g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 MOSFET

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}		400	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	$T_{\text{vj}} = 175^\circ\text{C}$, $V_{\text{GS}} = 18 \text{ V}$ $T_{\text{H}} = 75^\circ\text{C}$	400	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_{p} limited by T_{vjmax}	800	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	$D = 0.01$	-10/23	V

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}		-7/20	V

Tabelle 4 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 5 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	$I_D = 400\text{ A}$	$V_{GS} = 18\text{ V},$ $T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.44	2.27	mΩ
			$V_{GS} = 18\text{ V},$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$		2.33		
			$V_{GS} = 18\text{ V},$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		3.09		
			$V_{GS} = 15\text{ V},$ $T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.71		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	$I_D = 224\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25\text{ °C},$ (tested after 1ms pulse at $V_{GS} = +20\text{ V}$)		3.45	4.3	5.15	V
Gateladung	Q_G	$V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$			1.6		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			0.9		Ω
Eingangskapazität	C_{ISS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V},$ $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		48.4		nF
Ausgangskapazität	C_{OSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V},$ $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		2.4		nF
Rückwirkungskapazität	C_{rSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V},$ $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.158		nF
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	$V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			945		μJ
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	$V_{DS} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -3\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.32	660	μA
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GS} = 20\text{ V}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ on}$	$I_D = 400\text{ A}, R_{Gon} = 3.6\text{ }\Omega,$ $V_{DS} = 600\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		108		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		101		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		98.2		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_D = 400 \text{ A}$, $R_{Gon} = 3.6 \Omega$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	137		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	124		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	124		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ off}$	$I_D = 400 \text{ A}$, $R_{Goff} = 1 \Omega$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	136		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	150		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	156		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_D = 400 \text{ A}$, $R_{Goff} = 1 \Omega$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	32.2		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	33.7		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	34.3		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_D = 400 \text{ A}$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $L_\sigma = 18 \text{ nH}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$, $R_{Gon} = 3.6 \Omega$, $di/dt = 8.7 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	17.7		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	17.9		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	18.7		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_D = 400 \text{ A}$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $L_\sigma = 18 \text{ nH}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$, $R_{Goff} = 1 \Omega$, $dv/dt = 14 \text{ kV}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	2.83		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	3.28		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	3.52		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET		0.128		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	°C

Anmerkung: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

$T_{vj,op} > 150 \text{ °C}$ is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13.

3 Body diode

Tabelle 6 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	$T_{vj} = 175 \text{ °C}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$	$T_H = 75 \text{ °C}$	160	A

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_{SD}	$I_{SD} = 400 \text{ A}, V_{GS} = -3 \text{ V}$		3.98	5.05	V
				3.75		
				3.65		

4 NTC-Widerstand

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ °C}, R_{100} = 493 \text{ Ω}$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K

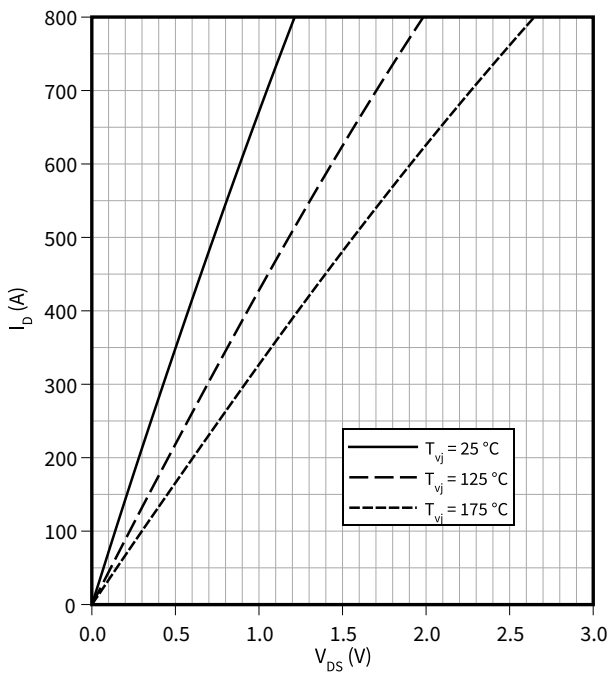
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

5 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

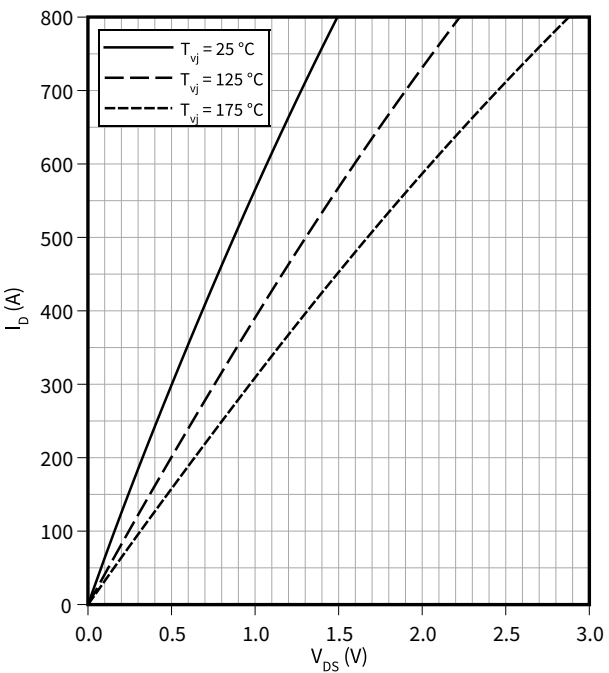
$V_{GS} = 18\text{ V}$



Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

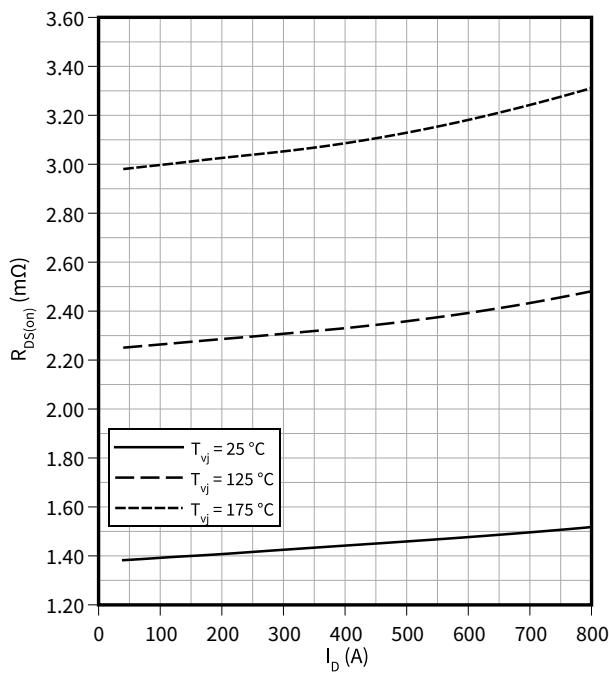
$V_{GS} = 15\text{ V}$



Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

$R_{DS(on)} = f(I_D)$

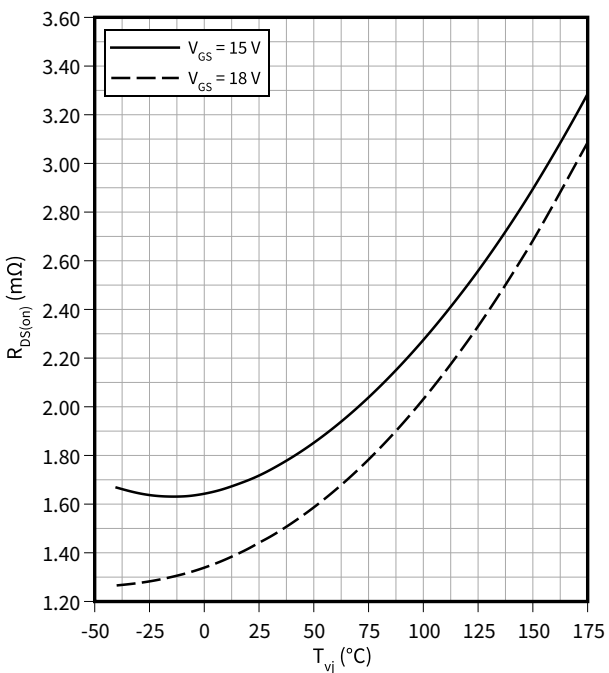
$V_{GS} = 18\text{ V}$



Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

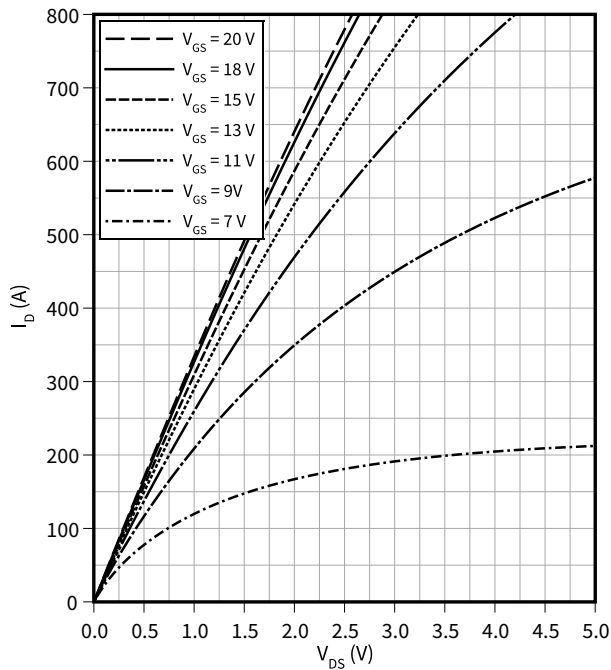
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$

$I_D = 400\text{ A}, V_{GS} = 18\text{ V}$



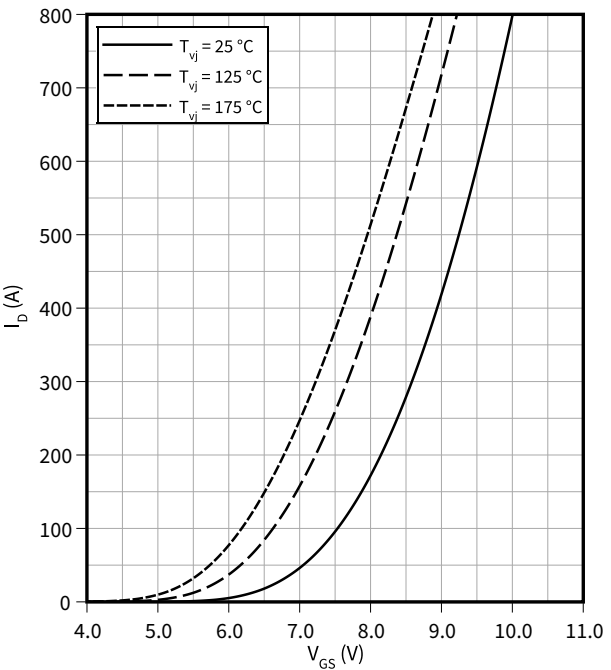
Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$



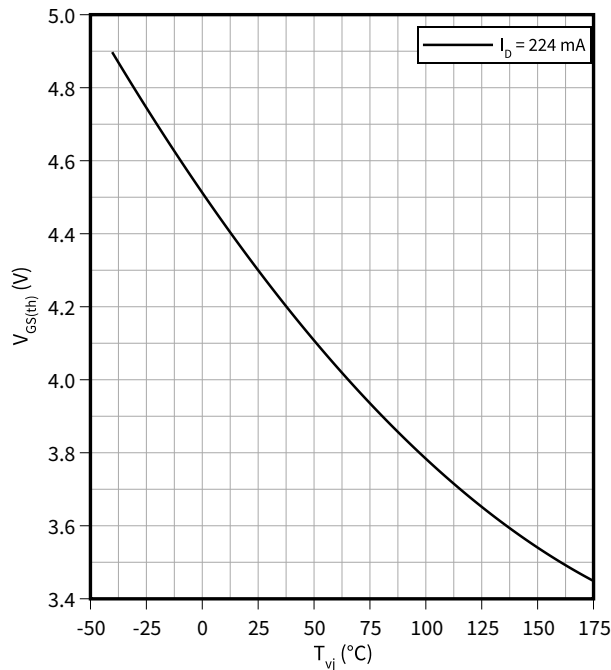
Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{GS})$
 $V_{DS} = 20\text{ V}$



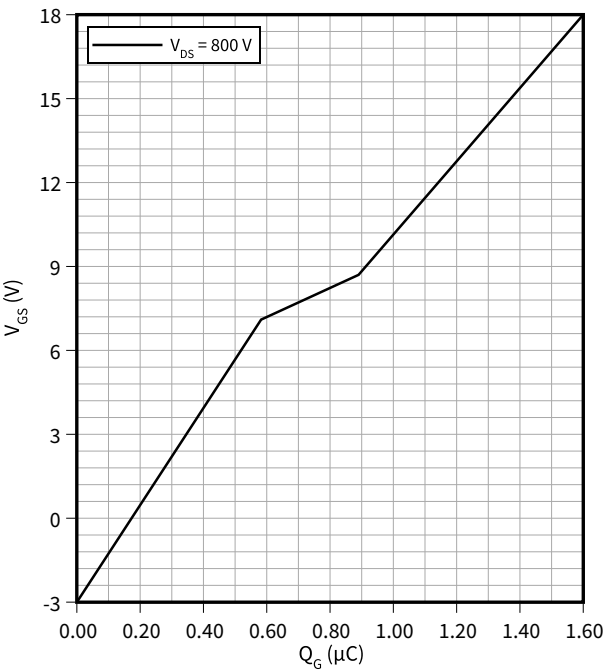
Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
 $V_{GS} = V_{DS}$



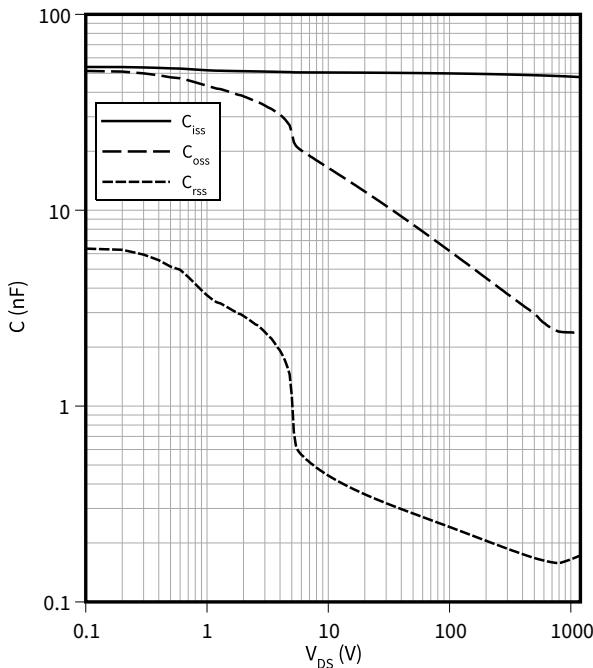
Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET

$V_{GS} = f(Q_G)$
 $I_D = 400\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



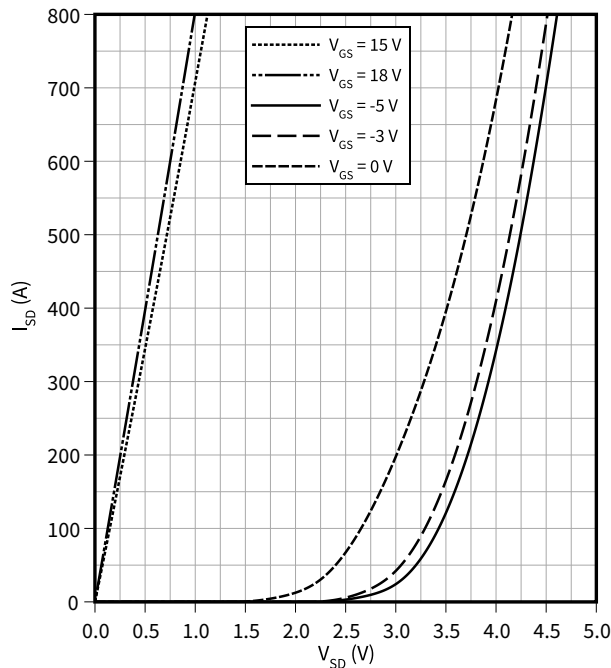
Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET

$C = f(V_{DS})$
 $f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25 \text{ °C}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$



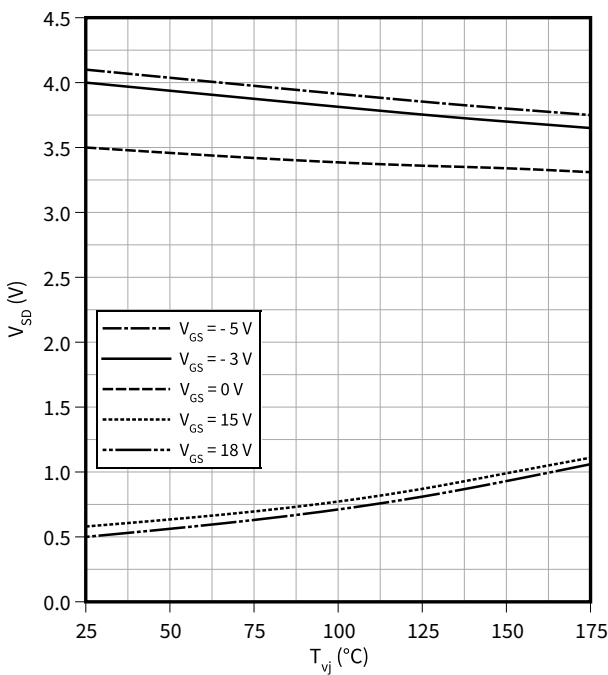
Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET

$I_{SD} = f(V_{SD})$
 $T_{vj} = 25 \text{ °C}$



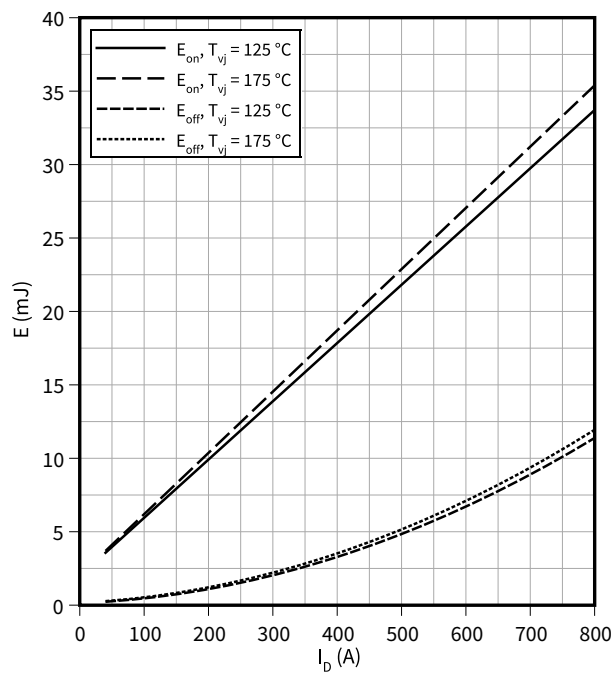
Durchlassspannung der Body-Diode (typisch), MOSFET

$V_{SD} = f(T_{vj})$
 $I_{SD} = 400 \text{ A}$



Schaltverluste (typisch), MOSFET

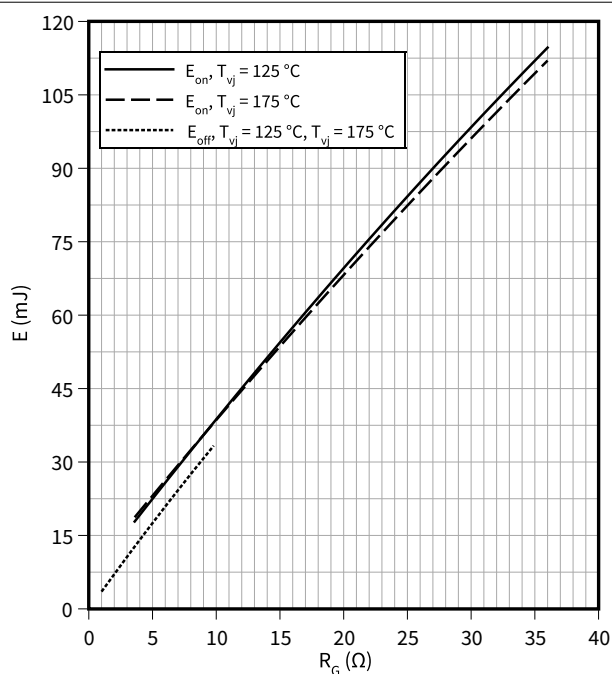
$E = f(I_D)$
 $R_{Goff} = 1 \text{ } \Omega$, $R_{Gon} = 3.6 \text{ } \Omega$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$$E = f(R_G)$$

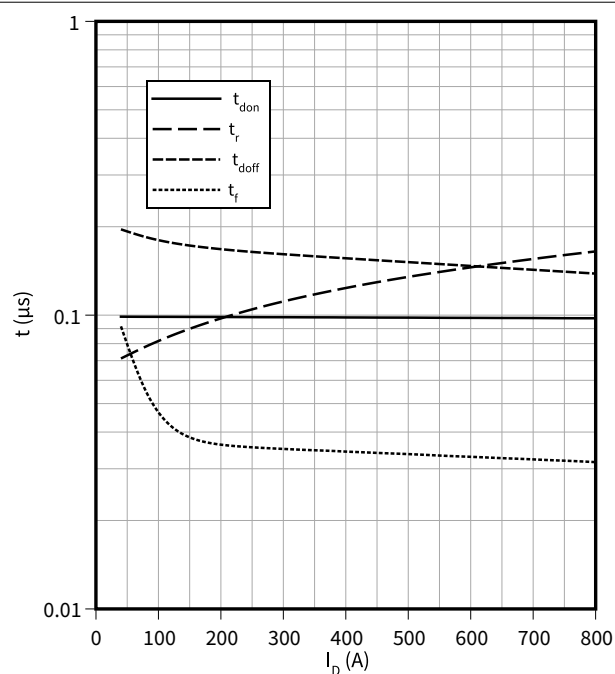
$V_{DS} = 600 \text{ V}$, $I_D = 400 \text{ A}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$$t = f(I_D)$$

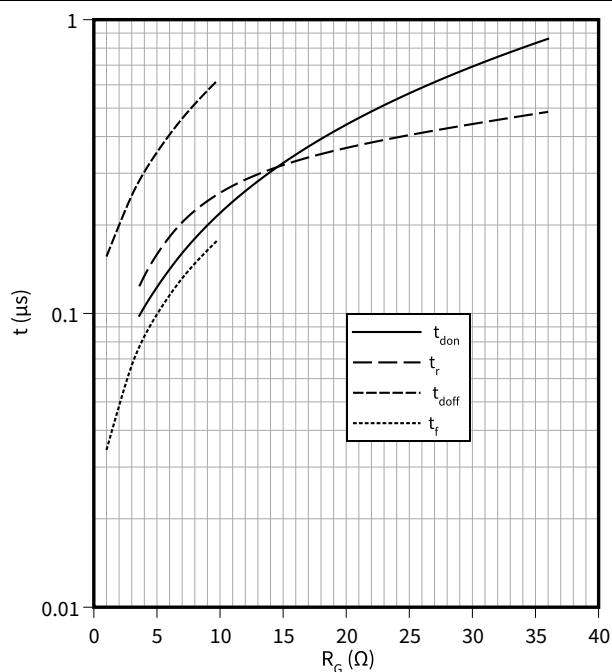
$R_{Goff} = 1 \text{ } \Omega$, $R_{Gon} = 3.6 \text{ } \Omega$, $V_{DS} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ } ^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$$t = f(R_G)$$

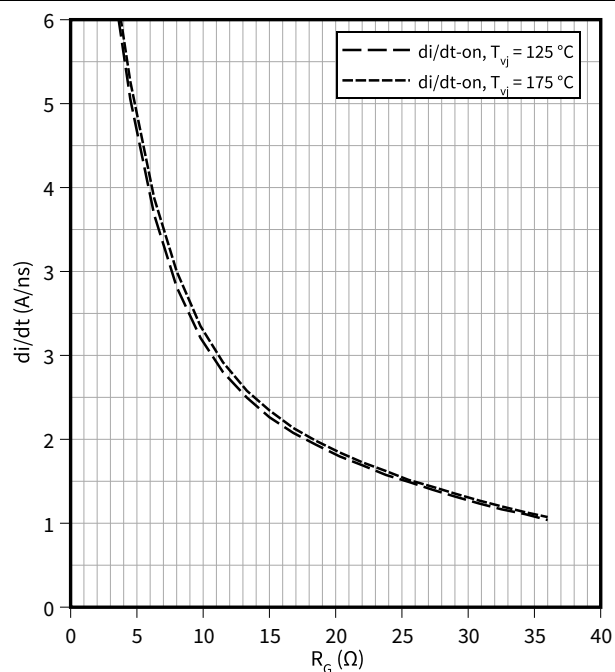
$V_{DS} = 600 \text{ V}$, $I_D = 400 \text{ A}$, $T_{vj} = 175 \text{ } ^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Stromsteilheit (typisch), MOSFET

$$di/dt = f(R_G)$$

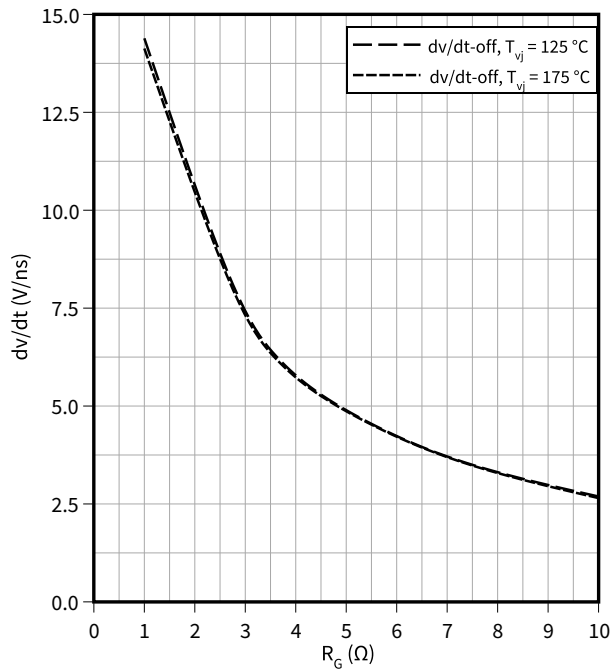
$V_{DS} = 600 \text{ V}$, $I_D = 400 \text{ A}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET

$dv/dt = f(R_G)$

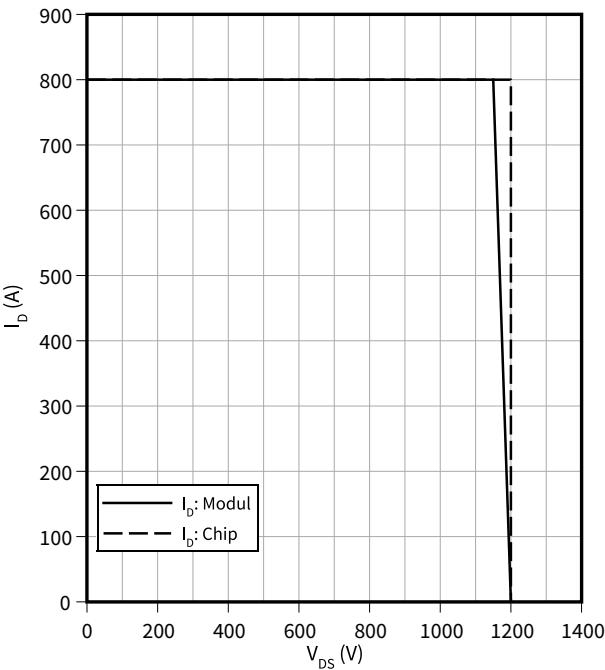
$V_{DS} = 600\text{ V}$, $I_D = 400\text{ A}$, $V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET

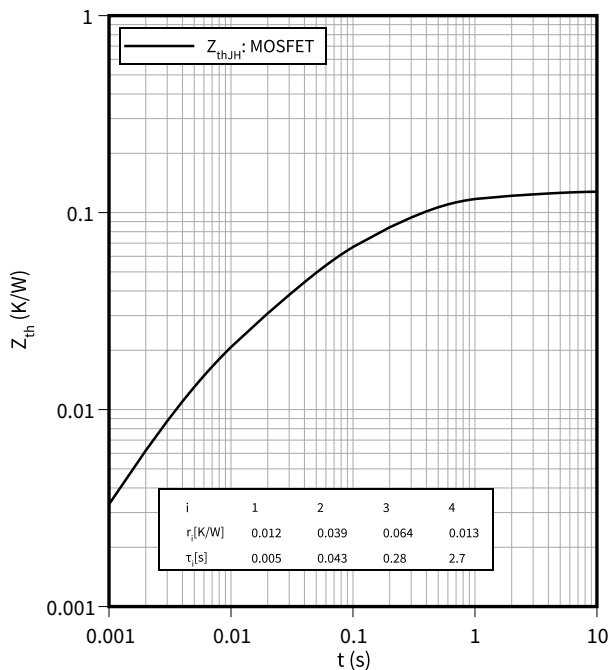
$I_D = f(V_{DS})$

$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$, $V_{GS} = -3/18\text{ V}$



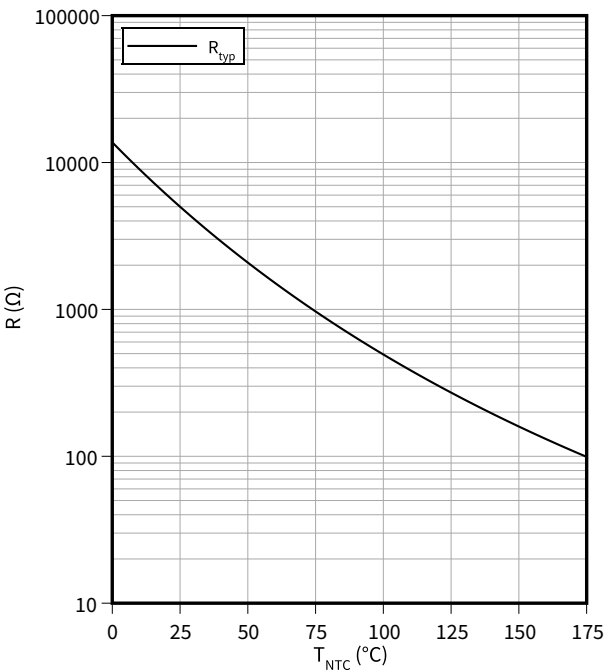
Transienter Wärmewiderstand , MOSFET

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



6 Schaltplan

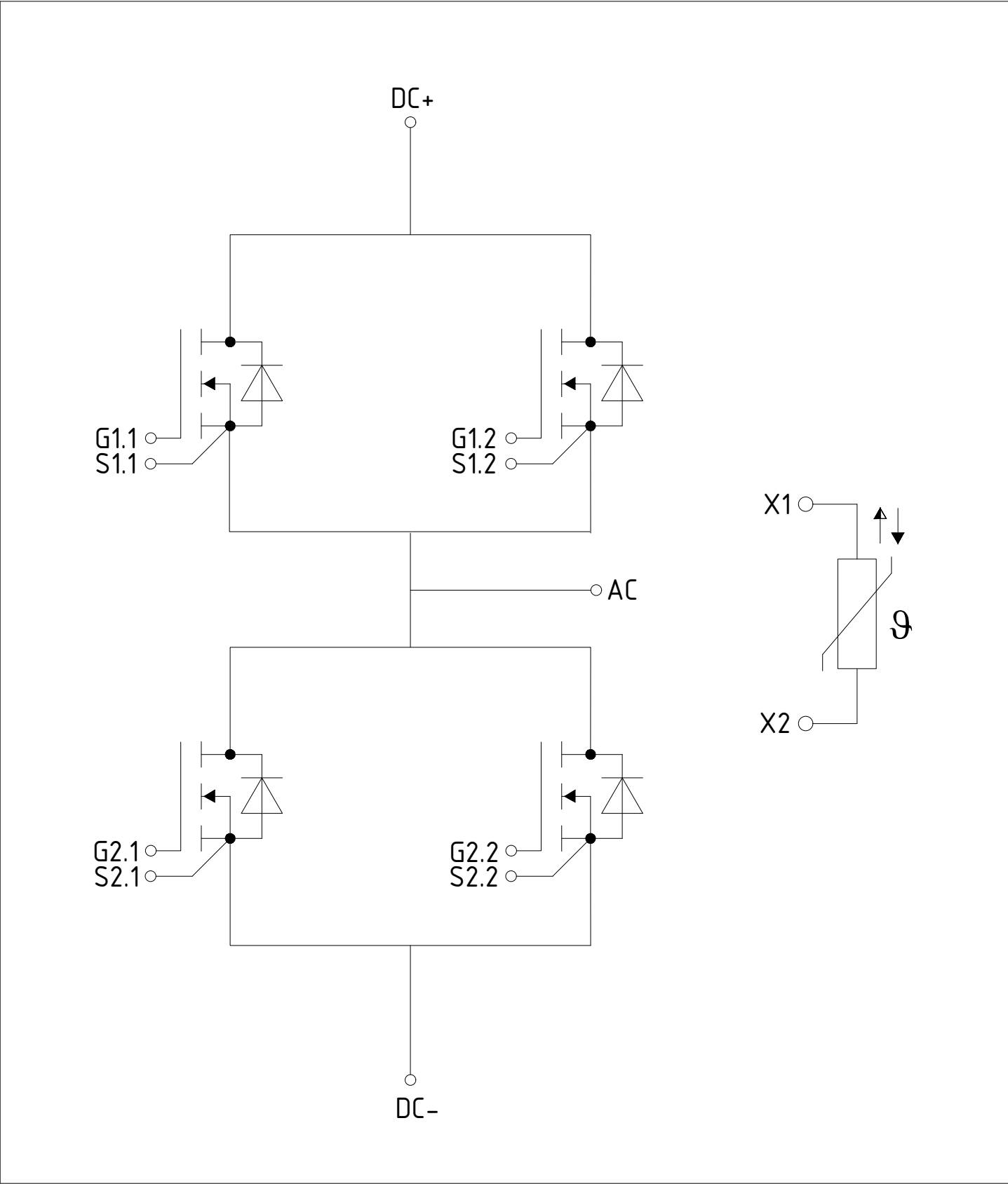


Abbildung 1

dimensioned for EJT Delta PT WN5451 25
choose length according to pcb thickness
max. screw-in depth 8,5mm

62 ± 0,45

14

14

62 ± 0,45

109,85 ± 0,45

Distance of threaded holes in heatsink

109,35 ± 0,1

2x Ø5,4 ± 0,1

Ø4,2

4x

Ø3,4

12

16,4

recommended pcb design height

pcb hole pattern

26
24
20,8
17,6
16,4
14,4
12,2
8
6,8
1,6
0
1,6
8
8
11,2
14,4
17,6
20,8
24
26

AC

DC

DC+

S2.1

G2.1

AC

DC

DC+

AC

AC

DC

DC+

S1.1

G1.1

X1

X2

G1.2

S1.2

1,78
3,78
3,78
23,78
20,8
1,78
4,78
1,78
10,78
3,78
4,78

Details about hole specification for contacts refer to AN2009-01 chapter 2
- Diameters of drill Ø1,15mm
- Copper thickness in hole 25-50um

W00T8B32.02

Abbildung 2

8 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2021-04-27	Target datasheet
1.00	2022-03-08	Final datasheet
1.10	2022-04-13	- Correction of switching times dimension. - Add of missing dv/dt and di/dt in table for dynamic parameters

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-04-13

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAV103-003

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.